



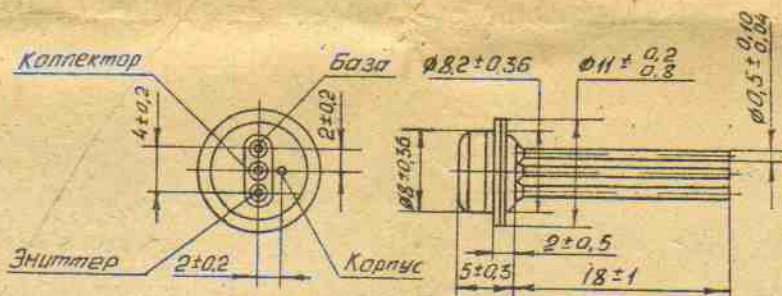
Транзисторы ИТЗ11А, ИТЗ11Б,
ИТЗ11Г, ИТЗ11Д, ИТЗ11К, ИТЗ11Л

Э Т И К Е Т К А

Германиевые планарные п-р-п биполярные транзисторы ИТЗ11А, ИТЗ11Б, ИТЗ11Г, ИТЗ11Д, ИТЗ11К, ИТЗ11Л.

Климатическое исполнение УХЛ и В.

Чертеж общего вида



Масса не более 2 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t = 25^{\circ}\text{C}$

Т и п транзистора	Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а	
			не менее	не более
ИТЗ11А	Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора ($U_c = 3 \text{ В}$, $I_E = 15 \text{ мА}$, $f = 50 - 1000 \text{ Гц}$, $Q = 10 - 100$)	h_{21E}	15	180
ИТЗ11Б			30	180
ИТЗ11Г			30	80
ИТЗ11Д			60	180
ИТЗ11К			60	180
ИТЗ11Л			150	300
ИТЗ11А	Модуль коэффициента передачи тока биполярного транзистора на высокой частоте ($U_c = 5 \text{ В}$, $I_E = 5 \text{ мА}$, $f = 100 \text{ мГц}$)	$ h_{21E} $	3	10
ИТЗ11Б			3	10
ИТЗ11Г			4,5	15
ИТЗ11Д			6	15
ИТЗ11К			4,5	15
ИТЗ11Л			6	15
ИТЗ11А	Напряжение насыщения база - эмиттер, В ($I_c = 15 \text{ мА}$, $I_b = 1,5 \text{ мА}$)	$U_{BE sat}$	-	0,6
ИТЗ11Б			-	0,6
ИТЗ11Г	Напряжение насыщения коллектор - эмиттер, В ($I_c = 15 \text{ мА}$, $I_b = 1,5 \text{ мА}$)	$U_{CE sat}$	-	0,3
ИТЗ11Д			-	0,3
ИТЗ11К			-	0,3
ИТЗ11Л	Обратный ток коллектора, мкА ($U_c = 12 \text{ В}$)	I_{cbo}	-	5

Т и п транзистора	Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а	
			не менее	не более
ИТЗ1А	Граничное напряжение базопричного транзистора, В ($I_{EM} = 10 \text{ mA}$)	$U_{(L)CEO}$	10	-
ИТЗ1Б			8	-
ИТЗ1Г				
ИТЗ1Д				
ИТЗ1К ИТЗ1Л				
ИТЗ1А ИТЗ1Б ИТЗ1Г ИТЗ1Д ИТЗ1К ИТЗ1Л	Обратный ток эмиттера, мкА ($U_E = 2 \text{ В}$)	I_{EBO}	-	10
ИТЗ1А	Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте биполярного транзистора, пс ($U_C = 5 \text{ В}$, $I_E = 5 \text{ mA}$, $f = 5 \text{ МГц}$)	τ_c	-	50
ИТЗ1Б			-	100
ИТЗ1Г			-	75
ИТЗ1Д			-	75
ИТЗ1К			-	75
ИТЗ1Л			-	75
ИТЗ1А ИТЗ1Б	Емкость эмиттерного перехода, пФ ($U_E = 0,25 \text{ В}$, $f = 10 \text{ МГц}$)	C_e	-	5
ИТЗ1Г ИТЗ1Д	Емкость коллекторного перехода, пФ ($U_C = 5 \text{ В}$, $f = 10 \text{ МГц}$)	C_c	-	2,5
ИТЗ1К ИТЗ1Л	Время рассасывания для биполярного транзистора, нс ($I_C = 20 \text{ mA}$, $I_{s1} = I_{s2}$)	t_s	-	50
ИТЗ1А	Коэффициент шума биполярного транзистора, дБ ($U_C = 5 \text{ В}$, $I_E = 5 \text{ mA}$, $f = 60 \text{ МГц}$)	F	-	7 (у 10% транзисторов $F \leq 8 \text{ дБ}$)

Содержание драгоценных металлов в расчете на 1000 шт. транзисторов

Золото _____ г

Серебро _____ г

В том числе:

Золото $0,0076 \cdot 10^{-3}$ г/мм на 4 выводах длиной 18 ± 1 мм

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы ИТЗ1А, ИТЗ1Б, ИТЗ1Г, ИТЗ1Д, ИТЗ1К, ИТЗ1Л соответствуют техническим условиям ИКЗ.365.156 ТУ.

Принято по извещению № 53 от 12/01/90

дата

ОТК-87

14